

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:



(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ☒; Nội dung không đúng thì để trống: ☐)

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ☒;

Giảng viên thỉnh giảng ☐

Ngành: Vật lý;

Chuyên ngành: Vật lý kỹ thuật

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên người đăng ký: LÊ VIỆT CƯỜNG

2. Ngày tháng năm sinh: 20/08/1985;

Nam ☒;

Nữ ☐;

Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: ☒

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà 28, ngõ 580, đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

6. Địa chỉ liên hệ: phòng 207, nhà E4, số 144, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại di động: 0986370170;

E-mail: cuonglv@vnu.edu.vn

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):

- Từ 8/2008 đến 9/2010: Cán bộ tạo nguồn, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

- Từ 10/2010 đến 4/2011: Học viên thực tập, Viện nghiên cứu Néel, Cộng hòa Pháp

- Từ 5/2011 đến 6/2015: Cán bộ tạo nguồn, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

- Từ 7/2015 đến 8/2015: Trao đổi nghiên cứu, Đại học Ulsan, Hàn Quốc

- Từ 9/2015 đến 7/2018: Cán bộ tạo nguồn, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

- Từ 8/2018 đến 9/2018: Giảng viên, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
- Từ 10/2018 đến 11/2021: Nghiên cứu viên trao đổi, Công ty IMRA JAPAN, thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản
- Từ 12/2021 đến nay: Giảng viên, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
- Chức vụ:

+ Hiện nay: Phó Chủ nhiệm phụ trách bộ môn, Bộ môn Kỹ thuật năng lượng, Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano (VLKT&CNNN), Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

+ Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Chủ nhiệm phụ trách bộ môn, Bộ môn Kỹ thuật năng lượng, Khoa VLKT&CNNN, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

- Cơ quan công tác hiện nay: Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
- Địa chỉ cơ quan: Nhà E3, số 144, đường Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại cơ quan: (024) 37549429 (Văn phòng Khoa VLKT&CNNN)
- Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): *Không có./*

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...

- Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):
- Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ): *Không có./*

9. Trình độ đào tạo:

- Được cấp bằng ĐH ngày 24 tháng 6 năm 2008, số văn bằng: QC 060130, ngành: Vật lý kỹ thuật, nơi cấp bằng ĐH: Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN
- Được cấp bằng ThS ngày 24 tháng 11 năm 2010, số văn bằng: PARXI 8256042/2010200903358, ngành: Thông tin, hệ thống và công nghệ, chuyên ngành: Công nghệ micro và nano, nơi cấp bằng ThS: Trường Đại học Paris 11, Cộng hòa Pháp.
- Được cấp bằng TS ngày 22 tháng 6 năm 2018, số văn bằng: QT 001621, ngành: Vật lý, chuyên ngành: Vật liệu và linh kiện nano, nơi cấp bằng TS: Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành:

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh *Phó Giáo Sư* tại HĐGS cơ sở: Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh *Phó Giáo Sư* tại HĐGS ngành, liên ngành: Vật lý

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:

- Nghiên cứu chế tạo các cảm biến hoạt động dựa trên các hiệu ứng từ và hiệu ứng quang.
- Nghiên cứu chế tạo các vật liệu ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng như vật liệu đa pha sắt, vật liệu siêu dẫn, vật liệu cho siêu tụ điện, vật liệu cho pin mặt trời...

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

- Đã hướng dẫn 2 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS;
- Đã hoàn thành 4 đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên, trong đó: 2 đề tài cấp Trường Đại học Công nghệ, 2 đề tài cấp ĐHQGHN;
- Đã công bố 43 bài báo KH, trong đó 32 bài báo KH trên tạp chí quốc tế có uy tín;
- Đã được cấp 5 bằng sáng chế;

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):

STT	Giải thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
1.	Bằng khen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tục từ 2023 đến 2024	ĐHQGHN	2025
2.	Giấy khen có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025	Trường ĐH Công nghệ	2025
3.	Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2024	Trường ĐH Công nghệ	2024
4.	Bằng khen có thành tích xuất sắc trong NCKH và đổi mới sáng tạo năm 2024	ĐHQGHN	2024
5.	Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024	Đảng ủy Trường ĐH Công nghệ	2024
6.	Giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2023 - 2024	BCH công đoàn ĐHQGHN	2024
7.	Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2022 - 2023	Trường ĐH Công nghệ	2023
8.	Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong NCKH và đổi mới sáng tạo năm 2023	ĐHQGHN	2023
9.	Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023	Đảng ủy Trường ĐH Công nghệ	2023
10.	Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022	Đảng ủy Trường ĐH Công nghệ	2022

STT	Giải thưởng	Cấp khen thưởng	Năm khen thưởng
11.	Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020	Đảng ủy tại Nhật Bản	2020
12.	Giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2017 - 2018	BCH công đoàn Trường ĐH Công nghệ	2018
13.	Giấy khen có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2016 - 2017	BCH công đoàn Trường ĐH Công nghệ	2017
14.	Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2010 - 2011	Trường ĐH Công nghệ	2011
15.	Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp cơ sở năm 2011	Trường ĐH Công nghệ	2011
16.	Bằng khen cho Sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải năm 2008	Bộ Giáo dục & Đào tạo	2008

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực của quyết định): *Không có./*

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:

Trong quá trình công tác tại Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN từ năm 2008 đến nay, đặc biệt giai đoạn từ năm 2022, tôi luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thể hiện sự tâm huyết, chuyên nghiệp và cầu toàn trong công việc. Tôi có tư duy học thuật hiện đại, sẵn sàng học hỏi, có tinh thần cởi mở, hợp tác tốt với đồng nghiệp và sinh viên. Tôi cũng tích cực tham gia quảng bá hình ảnh của Khoa và Nhà trường, chủ động thúc đẩy hợp tác nhằm tạo thêm cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên.

- *Về giảng dạy*: tôi chủ động cập nhật, xây dựng đề cương học phần và bài giảng chi tiết phù hợp với trình độ người học, lựa chọn phương pháp giảng dạy cơ bản, dễ hiểu, sát thực tế, giúp sinh viên phát triển tư duy phân tích và khả năng đánh giá. Tôi không ngại học kiến thức mới để tham gia giảng dạy các học phần mới. Bên cạnh đó, tôi tích cực hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, tham gia Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc, hướng dẫn học viên cao học.

- *Về nghiên cứu khoa học*: tôi duy trì hoạt động công bố quốc tế hàng năm bằng cách chủ động nghiên cứu và viết bài gửi tới các tạp chí uy tín. Đồng thời, tích cực tìm kiếm hợp tác nghiên cứu với các đồng nghiệp trong và ngoài nước, cũng như từ doanh nghiệp, để phát triển các hướng nghiên cứu bền vững, liên ngành về cảm biến, năng lượng và ứng dụng. Tôi kết hợp linh hoạt giữa nghiên cứu thực nghiệm và phân tích lý thuyết để tiếp cận vấn đề một cách toàn diện. Đến nay, tôi đã chủ nhiệm và tham gia nhiều đề tài

nghiên cứu khoa học, là tác giả chính và đồng tác giả của nhiều công bố quốc tế có uy tín và một số bằng sáng chế quốc tế.

- *Về phục vụ và phát triển cộng đồng*: tôi tích cực tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và diễn đàn nghiên cứu dành cho sinh viên, như hội nghị quốc tế về Khoa học vật liệu tiên tiến năm 2022 (FMS 2022), hội thảo song phương Nhật Bản – Việt Nam về Khoa học và Công nghệ cho Không gian và Trái đất (JVBSSESE 2023), Student Forum 2023. Tôi cũng thường xuyên tham dự các hội nghị khoa học chuyên ngành trong và ngoài nước. Ngoài ra, tôi tham gia phản biện cho các tạp chí quốc tế uy tín, đồng thời đảm nhiệm vai trò trong các hội đồng chấm khóa luận/ đề án tốt nghiệp, luận văn, luận án nhằm đóng góp cho cộng đồng khoa học và nâng cao năng lực chuyên môn. Tôi là thành viên tích cực của các tổ công tác xây dựng báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chương trình đào tạo, xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo cũ và mới của Khoa VLKT&CNNN. Bên cạnh đó, tôi chủ động kết nối với doanh nghiệp và cộng đồng cựu sinh viên để mở rộng hợp tác, phát triển ngành học và nâng cao cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên cũng như cựu sinh viên.

Căn cứ theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 được sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tôi nhận thấy bản thân đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn để xét đạt chức danh Phó Giáo Sư.

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 12 năm

- Khai cụ thể ít nhất 6 năm học, trong đó có 3 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đề án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp/số giờ chuẩn gd quy đổi/số giờ chuẩn định mức (*)
		Chính	Phụ			ĐH	SĐH	
1.	2009-2010					180		180/ 147/ 120
2.	2017-2018				1	225.25		225.25/ 195.35/ 180
3.	2021-2022					165		165/ 201.67/ 135
3 năm học cuối								
4.	2022-2023			1	5.5	349.25		349.25/ 417.57/ 270
5.	2023-2024				4	217.75	30	247.75/ 335.48/ 270

TT	Năm học	Số lượng NCS đã hướng dẫn		Số lượng ThS/CK2/BSNT đã hướng dẫn	Số đề án, khóa luận tốt nghiệp ĐH đã HD	Số giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp		Tổng số giờ chuẩn gd trực tiếp trên lớp/số giờ chuẩn gd quy đổi/số giờ chuẩn định mức (*)
		Chính	Phụ			ĐH	SĐH	
6.	2024-2025			1	2.5	293		293/ 356/ 216

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.

3. Ngoại ngữ:

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Anh

a) Được đào tạo ở nước ngoài ☐:

- Học ĐH ☐; Tại nước:; Từ năm đến năm

- Bảo vệ luận văn ThS ☐ hoặc luận án TS ☐ hoặc TSKH ☐; Tại nước:

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước ☐:

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng:; năm cấp:

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài ☐:

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

d) Đối tượng khác ☒; Diễn giải: Học chương trình Thạc sỹ của Trường Đại học Paris 11 tại Trường Đại học Công nghệ, do các Giáo sư của Trường Đại học Paris 11 trực tiếp giảng dạy 100% bằng Tiếng Anh. Bảo vệ luận văn ThS bằng Tiếng Anh trực tuyến với hội đồng ở Pháp. Ngoài ra, ứng viên cũng có nhiều thời gian làm việc ở nước ngoài bằng tiếng Anh: 6 tháng ở Pháp, 2 tháng ở Hàn Quốc, 3 năm ở Nhật.

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): VSTEP B2 do Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN cấp.

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng:

TT	Họ tên NCS hoặc HVCH/CK2/BSNT	Đối tượng		Trách nhiệm hướng dẫn		Thời gian hướng dẫn	Cơ sở đào tạo	Ngày, tháng, năm được cấp bằng/có quyết định cấp bằng
		NCS	HVCH/CK2/BSNT	Chính	Phụ			
1.	Vũ Hoàng Linh		X		X	2/2023 - 7/2023	Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQGHN	6/9/2023
2.	Nguyễn Đức Hiếu		X	X		7/2024 - 3/2025	Trường ĐH Công nghệ, ĐHQGHN	5/5/2025

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai số lượng NCS.

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học trở lên: *Không có./.*

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu:

TT	Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ (CT, ĐT...)	CN/PCN/TK	Mã số và cấp quản lý	Thời gian thực hiện	Thời gian nghiệm thu (ngày, tháng, năm)/Xếp loại KQ
I	Trước khi được công nhận TS				
1	Nghiên cứu và chế tạo màng mỏng từ cấu trúc nano có dị hướng từ tính thể cao	CN	CN.10.12, Trường ĐH Công nghệ	8/2010 - 1/2012	27/02/2012, Tốt
2	Nghiên cứu sự biến thiên từ trường của các nam châm từ cứng kích thích micro và khả năng ứng dụng	CN	CN.14.11, Trường ĐH Công nghệ	7/2014 - 7/2015	25/06/2015, Tốt
II	Sau khi được công nhận TS				
3	Nghiên cứu chế tạo các vi cấu trúc từ có biến thiên từ trường lớn bằng phương pháp in, định hướng ứng dụng phân tách tế bào	CN	CA.22.05A, Trung tâm hỗ trợ nghiên cứu Châu Á, ĐHQGHN	8/2022 - 7/2024	7/2024, Xuất sắc
4	Nghiên cứu chế tạo cảm biến chiết suất dựa trên hiệu ứng trường phân tán	CN	QG.23.36, ĐHQGHN	4/2023 - 4/2025	- Đã họp Hội đồng nghiệm thu ngày 28/5/2025, Đạt. - Đang làm thủ tục thanh lý.

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư ký.

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:

TT	Tên bài báo/báo cáo khoa học	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
I.	Trước khi được công nhận TS							
1.	Optimization of spin-valve structure NiFe/Cu/NiFe/IrMn for planar Hall effect based biochips	7		IEEE Transactions on Magnetics ISSN: 0018-9464 DOI: 10.1109/TMAG.2009.2018580	Scopus (1.2, Q2)	25	45, 6, 2378-2382	6/2009
2.	Optimization of planar Hall effect sensor for magnetic bead detection using spin-valve NiFe/Cu/NiFe/IrMn structures	5		Journal of Physics: Conference Series ISSN: 1742-6588 DOI: 10.1088/1742-6596/187/1/012056	Scopus	9	187, 012056	9/2009
3.	Nghiên cứu chế tạo màng từ tính FePt/Al trên đế Si	3	X	Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 6			130-133	11/2009
4.	Voltage-controllable magnetic behavior in PZT/NiFe/CoFe nanocomposites	5		Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology ISSN: 2043-6262 DOI: 10.1088/2043-6262/2/1/015015	Scopus (1.28, Q2)	6	2, 1, 015015	3/2011
5.	Switchable voltage control of the magnetic anisotropy in heterostructured nanocomposites of CoFe/NiFe/PZT	7		Journal of the Korean Physical Society ISSN: 1976-8524 DOI: 10.3938/jkps.63.812	Scopus (0.48, Q3)	4	63, 812-816	8/2013
6.	Electrical field induced magnetization switching in CoFe/NiFe/PZT multiferroics	5		IEEE Transactions on Magnetics ISSN: 0018-9464 DOI: 10.1109/TMAG.2014.2304518	Scopus (1.95, Q2)	5	50, 6, 1-4	6/2014

TT	Tên bài báo/báo cáo khoa học	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
7.	Micro-magnetic imprinting of high field gradient magnetic flux sources	13		Applied Physics Letters ISSN: 1077-3118 DOI: 10.1063/1.4886375	ISI (3.69, Q1)	51	104, 262401	6/2014
8.	Sorting and trapping human cells using a matrix of square micro-magnets	3	X	Materials Transactions ISSN: 1345-9678 DOI: 10.2320/matertrans.MA201563	ISI (0.83, Q2)	7	56, 9, 1431-1433	8/2015
9.	Room-temperature ferromagnetism in Nickel-doped wide band gap ferroelectric Bi _{0.5} K _{0.5} TiO ₃ nanocrystals	8		Materials Transactions ISSN: 1345-9678 DOI: 10.2320/matertrans.MA201548	ISI (0.83, Q2)	27	56, 9, 1339-1343	8/2015
10.	Room-temperature ferromagnetism in Fe-doped wide band gap ferroelectric Bi _{0.5} K _{0.5} TiO ₃ nanocrystals	6		Materials Letters ISSN: 0167-577X DOI: 10.1016/j.matlet.2015.05.010	ISI (2.65, Q1)	55	156, 129-133	10/2015
11.	Các tính chất về cấu trúc và từ của màng NdFeB	3	X	Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9			1, 4-6	11/2015
12.	Growth mechanism and stability of magnetite nanoparticles synthesized by the hydrothermal method	7		Journal of Nanoscience and Nanotechnology ISSN: 1533-4899 DOI: 10.1166/jnn.2016.1110	Scopus (1.43, Q2)	26	16, 7, 7373-7379	7/2016
13.	Origin of room temperature ferromagnetism in Cr-doped lead free ferroelectric Bi _{0.5} Na _{0.5} TiO ₃ materials	8		Journal of Electronic Materials ISSN: 0361-5235 DOI: 10.1007/s11664-016-5248-0	ISI (1.67, Q2)	73	46, 3367-3372	1/2017
14.	Structural, optical, and magnetic properties of lead-free ferroelectric Bi _{0.5} K _{0.5} TiO ₃ solid	6		Journal of Electronic Materials ISSN: 0361-5235	ISI (1.67, Q2)	35	46, 3472-3478	2/2017

TT	Tên bài báo/báo cáo khoa học	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
	solution with BiFeO ₃ materials			DOI: 10.1007/s11664-017-5328-9				
15.	Observation of room-temperature ferromagnetism in Co-doped Bi _{0.5} K _{0.5} TiO ₃ materials	7	X	Applied Physics A: Materials Science and Processing ISSN: 1432-0630 DOI: 10.1007/s00339-017-1173-1	ISI (1.72, Q2)	17	123, 563-566	8/2017
16.	Effect of organic solvents on the properties of DWCNT/PEDOT:PSS transparent conductive films	7		Materials Research Express ISSN: 2053-1591 DOI: 10.1088/2053-1591/aa90ac	ISI (1.18, Q1)	12	4, 10, 105504 - 105511	10/2017
17.	Nghiên cứu chế tạo các nguồn vi năng lượng vĩnh cửu dựa trên vật liệu FePt	6	X	Kỷ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 10 ISBN: 978-604-95-0326-9			2, 707-709	10/2017
18.	Fabrication of micro-sized magnetic materials by ink-jet printing	3	X	Materials Transactions ISSN: 1345-9678 DOI: 10.2320/matertrans.MD201702	ISI (0.8, Q2)	3	59, 7, 1091-1094	6/2018
II.	Sau khi được công nhận TS							
19.	Effect of crystallization temperature on energy-storage density and efficiency of lead-free Bi _{0.5} (Na _{0.8} K _{0.2}) _{0.5} TiO ₃ thin films prepared by sol-gel method	7		Journal of Science: Advanced Materials and Devices ISSN: 2468-2284 DOI: 10.1016/j.jsamd.2019.04.008	ISI (4.23, Q1)	16	4, 3, 370-375	9/2019
20.	Tunable magnetism of Na _{0.5} Bi _{0.5} TiO ₃ materials via Fe defects	11		Journal of Superconductivity and Novel Magnetism ISSN: 1557-1939	ISI (1.35, Q3)	33	32, 3011-3018	10/2019

TT	Tên bài báo/báo cáo khoa học	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
				DOI: 10.1007/s10948-019-05163-z				
21.	Defect-mediated room temperature ferromagnetism in lead-free ferroelectric $\text{Na}_{0.5}\text{Bi}_{0.5}\text{TiO}_3$ materials	11		Journal of Superconductivity and Novel Magnetism ISSN: 1557-1939 DOI: 10.1007/s10948-019-05399-9	ISI (1.43, Q3)	28	33, 911-920	4/2020
22.	Characterization and microwave absorption properties of lead-free $\text{Bi}_{0.5}(\text{Na}_{0.8}\text{K}_{0.2})_{0.5}\text{TiO}_3$ by sol-gel method	11		VNU Journal of Science: Mathematics – Physics ISSN: 2615-9341 DOI: 10.25073/2588-1124/vnumap.4665			38, 1, 1-12	3/2022
23.	Hiện tượng bất ổn định trong các đường đo I-V của pin mặt trời cấu trúc ITO/Si:H/Ti/Au	4	X	Kỷ yếu hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 12 ISBN: 978-604-316-839-6			1, 310-313	8/2022
24.	Tính chất dập tắt huỳnh quang của thanh nano TiO_2 chế tạo bằng phương pháp thủy nhiệt	4		Kỷ yếu hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học Vật liệu toàn quốc lần thứ 12 ISBN: 978-604-316-839-6			1, 314-317	8/2022
25.	Nghiên cứu chế tạo dây các vi cấu trúc từ NdFeB bằng phương pháp in phun	1	X	Tạp chí nghiên cứu khoa học và quân sự ISSN: 1859-1043 DOI: 10.54939/1859-1043.j.mst.FEE.2022.309-314			số đặc san 12-2022, 309-314	12/2022
26.	Enhancement of magnetic field strength and gradient produced by an array of micro-sized	3	X	VNU Journal of Science: Mathematics – Physics ISSN: 2615-9341			39, 1, 74-82	3/2023

TT	Tên bài báo/báo cáo khoa học	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
	parallelepiped magnets			DOI: 10.25073/2588-1124/vnumap.4770				
27.	Levitation and position of T47D cells on a magnetic microsystem fabricated by ink jet printing	3	X	Journal of Applied Physics ISSN: 1089-7550 DOI: 10.1063/5.0155198	ISI (1.43, Q2)		134, 3, 034501	7/2023
28.	Enhancements of critical current density in $\text{Bi}_{1.6}\text{Pb}_{0.4}\text{Sr}_2\text{Ca}_2\text{Cu}_3\text{O}_{10+\delta}$ superconductors by additions of SnO_2 nanoparticles	12		Ceramics International ISSN: 0272-8842 DOI: 10.1016/j.ceramint.2023.06.047	ISI (5.43, Q1)	7	49, 16, 27614-27621	8/2023
29.	Arrays of NdFeB clusters in PDMS background used to levitate T47D human cells	3	X	Materials Transactions ISSN: 1345-9678 DOI: 10.2320/matertrans.MT-MG2022002	ISI (1.18, Q3)		64, 9, 2143-2146	8/2023
30.	Multiferroic property of 2D hybrid organic-inorganic $(\text{C}_6\text{H}_5\text{C}_2\text{H}_4\text{NH}_3)_2\text{NiCl}_4$ perovskite single crystals	4	X	Materials Transactions ISSN: 1345-9678 DOI: 10.2320/matertrans.MT-MG2022022	ISI (1.18, Q3)	1	64, 9, 2168-2173	8/2023
31.	Synthesis and microwave-absorption properties of novel $\text{Bi}_{1/2}(\text{Na}_{0.8}\text{K}_{0.2})_{1/2}\text{TiO}_3/\text{Fe}_3\text{O}_4$ composite	15		Materials Transactions ISSN: 1345-9678 DOI: 10.2320/matertrans.MT-MG2022026	ISI (1.18, Q3)	3	64, 10, 2450-2456	8/2023
32.	Effect of annealing temperature on I-V curves of ITO/aSi:H junction	4	X	The proceedings of the 4 th International Workshop on Advanced Materials and Devices ISBN: 978-604-350-270-1 https://nec-hus.edu.vn/iwamd2023/proceedings.html			153-156	8/2023

TT	Tên bài báo/báo cáo khoa học	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
33.	Magnetic anisotropy in 2D hybrid organic-inorganic $(C_6H_5C_2H_4NH_3)_2(Ni_{1-x}Mn_x)Cl_4$ Perovskite crystals	5	X	The proceedings of the 4 th International Workshop on Advanced Materials and Devices ISBN: 978-604-350-270-1 https://nec-hus.edu.vn/iwamd2023/proceedings.html			240-244	8/2023
34.	Surface plasmon resonance sensor with photodiode integrated beneath plasmonic layer	6	X	Journal of Science: Advanced Materials and Devices ISSN: 2468-2284 DOI: 10.1016/j.jsamd.2024.100711	ISI (6.9, Q1)		9, 2 100711	6/2024
35.	Synthesis and characterization of TiO ₂ nanorods for efficient electronic transport layer of perovskite solar cells	7	X	Journal of Electronic Materials ISSN: 0361-5235 DOI: 10.1007/s11664-024-11529-4	ISI (2.37, Q2)	2	53, 7291-7300	10/2024
36.	Nghiên cứu ảnh hưởng của lớp Ti tới độ ổn định của cảm biến cộng hưởng plasmon bề mặt loại đo dòng cấu trúc ITO/aSi:H/Ti/Au	5	X	Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN: 1859-4794			66, 22-27	10/2024
37.	Various CVD-grown ZnO nanostructures for nanodevices and interdisciplinary applications	4		Beilstein Journal of Nanotechnology ISSN: 2190-4286 DOI: 10.3762/bjnano.15.112	ISI (2.74, Q2)	2	15, 1390-1399	11/2024
38.	Optical properties of SiO ₂ opal crystals	11		Optical materials: X	ISI	1	24, 100362	12/2024

TT	Tên bài báo/báo cáo khoa học	Số tác giả	Là tác giả chính	Tên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học/ISSN hoặc ISBN	Loại tạp chí quốc tế uy tín: ISI, Scopus (IF, Qi)	Số lần trích dẫn (không tính tự trích dẫn)	Tập, số, trang	Tháng, năm công bố
	decorated with silver nanoparticles			ISSN: 2590-1478 DOI: 10.1016/j.omx.2024.100362	(2.69, Q2)			
39.	Improved flux pinning properties of Mg exceed MgB ₂ ceramics with B ₄ C and Dy ₂ O ₃ additions	17		Ceramics International ISSN 0272-8842 DOI: 10.1016/j.ceramint.2024.10.069	ISI (5.1, Q1)		50, 23, 51509-51515	12/2024
40.	Optimizing photodiode-integrated SPR sensor chips based on n-i junctions	6	X	Sensor and Actuator A: Physics ISSN 0924-4247 DOI: 10.1016/j.sna.2024.116159	ISI (4.52, Q1)		382, 116159	2/2025
41.	The transiently unstable phenomenon of I-V curves of ITO/a-Si:H junctions	5	X	Journal of Electronic Materials ISSN: 0361-5235 DOI: 10.1007/s11664-024-11710-9	ISI (2.37, Q2)		54, 1614-1624	3/2025
42.	Excess conductivity evaluation and mechanical properties of Fe ₅₀ Pd ₅₀ doping on the Bi _{1.6} Pb _{0.4} Sr ₂ Ca ₂ Cu ₃ O _{10+δ}	5		Journal of Alloys and Compounds ISSN: 0925-8388 DOI: 10.1016/j.jallcom.2025.180045	ISI (6.24, Q1)	2	1022, 180045	4/2025
43.	Superconductivity in Bi _{1.6} Pb _{0.4} Sr ₂ Ca ₂ Cu ₃ O _{10+δ} ceramics with cobalt ferrite (CoFe ₂ O ₄) nanoparticle addition	15		Ceramics International ISSN 0272-8842 DOI: 10.1016/j.ceramint.2025.01.451	ISI (5.1, Q1)	2	51, 12, 16134-16142	5/2025

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà UV là tác giả chính sau TS: 7 ([27], [29], [30], [34], [35], [40], [41])

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg): *Không có./*

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích:

TT	Tên bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích	Tên cơ quan cấp	Ngày tháng năm cấp	Tác giả chính/đồng tác giả	Số tác giả
1.	Tiếng Nhật: 電気測定型表面プラズモン共鳴センサ、電気測定型表面プラズモン共鳴センサチップ、及び表面プラズモン共鳴変化の検出方法 Tiếng Anh: Electrically measured surface plasmon resonance sensor, electrically measured surface plasmon resonance sensor chip, and method for detecting surface plasmon resonance change	Cơ quan sáng chế Nhật Bản https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=JP364668882&_fid=WO2021075529	22/4/2021	Đồng tác giả	6
2.	Electrical measurement-type surface plasmon resonance sensor, electrical measurement-type surface plasmon resonance sensor chip, and method for detecting change in surface plasmon resonance	Cơ quan sáng chế Trung Quốc https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=CN332890314&_fid=WO2021075529	23/7/2021	Đồng tác giả	6
3.	Electricity measuring type surface plasmon resonance sensor, electricity measuring type surface plasmon resonance sensor chip, method for detecting surface plasmon resonance changes	Cơ quan sáng chế Hoa Kỳ https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=US345564172&_fid=WO2021075529	23/12/2021	Đồng tác giả	6
4.	Electrical measurement-type surface plasmon resonance sensor, electrical measurement-type surface plasmon resonance sensor chip, and method for detecting change in surface plasmon resonance	Cơ quan sáng chế Châu Âu https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=EP372527227&_fid=WO2021075529	24/8/2022	Đồng tác giả	6
5.	Electrical measurement type surface plasmon resonance sensor and electrical measurement method using the same	Cơ quan sáng chế Nhật Bản https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=JP424165448&_cid=P20-LWCA0M-42286-1	22/2/2024	Tác giả chính	3

- Trong đó: 5 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp sau khi được cấp bằng TS.

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao): Không có./

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT	Chương trình đào tạo, chương trình nghiên cứu ứng dụng KHCN	Vai trò UV (Chủ trì/ Tham gia)	Văn bản giao nhiệm vụ (số, ngày, tháng, năm)	Cơ quan thẩm định, đưa vào sử dụng	Văn bản đưa vào áp dụng thực tế	Ghi chú
1.	CTĐT ngành Vật lý kỹ thuật	Thành viên	326A/QĐ-ĐHCN, ngày 14/4/2023	Trường ĐH Công nghệ	874/QĐ-ĐHCN, ngày 30/8/2023	Điều chỉnh, cập nhật CTĐT
2.	CTĐT ngành Kỹ thuật năng lượng	Thư ký			876/QĐ-ĐHCN, ngày 30/8/2023	
3.	CTĐT ngành Công nghệ vật liệu	Thư ký	2368/QĐ-ĐHCN, ngày 29/10/2024	Trường ĐH Công nghệ	3078/QĐ-ĐHCN, ngày 30/12/2024	Xây dựng CTĐT

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế *:

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):

b) Hoạt động đào tạo

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (UV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng):

- Giờ giảng dạy

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (UV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:

+ **Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (UV chức danh PGS) ☒**

* Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn chính 1 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng ThS/CK2/BSNT bị thiếu: công trình số [29] trong mục 7.1.a, cụ thể: Bài báo “*Arrays of NdFeB clusters in PDMS background used to levitate T47D human cells*”, công bố trên tạp chí Materials Transactions, tháng 8/2023 (IF 1.18, Q3), tập 64(9), trang 2143-2146. DOI: [10.2320/matertrans.MT-MG2022002](https://doi.org/10.2320/matertrans.MT-MG2022002)

c) Nghiên cứu khoa học

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (UV chức danh GS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (UV chức danh PGS) ☐

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ☐; 04 CTKH ☐

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH ☐

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc UV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2025

Người đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Việt Cường